

**Физика и техника полупроводников, 2018,
том 52, выпуск 9**

Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Окулич Е.В., Окулич В.И., Тетельбаум Д.И.

Расчет влияния плотности ионного тока и температуры на кинетику накопления точечных дефектов при облучении кремния легкими ионами

967

Толкачева Е.А., Маркевич В.П., Мурин Л.И.

Оптические свойства и механизм образования вакансионно-кислородных комплексов V_2O_2 и V_3O_2 в облученных кристаллах кремния

973

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Яфаров Р.К.

Влияние высокодозной имплантации углерода на фазовый состав, морфологию и автоэмиссионные свойства кристаллов кремния

980

Шкумбатюк П.С.

Поверхностное дефектообразование в CdTe при воздействии излучения CO_2 -лазера

986

Ширяев А.А., Воротынцев В.М., Шоболов Е.Л.

Эффект Пула--Френкеля и возможность его применения для прогнозирования радиационного накопления заряда в термическом диоксиде кремния

990

Ситников А.В., Жилова О.В., Бабкина И.В., Макагонов В.А., Калинин Ю.Е., Ремизова О.И.

Структура и электрические свойства пленок на основе оксида олова, легированных цирконием

995

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Стовпяга Е.Ю., Еуров Д.А., Курдюков Д.А., Смирнов А.Н., Яговкина М.А., Yakovlev D.R., Голубев В.Г.

Матричный синтез монодисперсных сферических нанокompозитных частиц $SiO_2/GaN:Eu^{3+}$

1000

Орлов Л.К., Волкова Н.С., Ивина Н.Л., Орлов М.Л.

Электрополевое поведение резонансных особенностей в туннельной составляющей фототока в гетероструктурах $InAs(QD)/GaAs$

1006

Кондратенко Т.С., Смирнов М.С., Овчинников О.В., Шабуня-Клячковская Е.В., Мацукович А.С., Звягин А.И., Винокур Я.А.

Размерно-зависимые оптические свойства коллоидных квантовых точек CdS, пассивированных тиогликолевой кислотой

1015

Иванов К.А., Губайдуллин А.Р., Калитеевский М.А.

Квантование электромагнитного поля в трехмерных фотонных структурах на основе формализма матрицы рассеяния (S-квантование)

1023

Смагина Ж.В., Зиновьев В.А., Кривякин Г.К., Родякина Е.Е., Кучинская П.А., Фомин Б.И., Яблонский А.Н., Степихова М.В., Новиков А.В., Двуреченский А.В.

Исследование структурных и излучательных свойств $Ge(Si)$ квантовых точек, упорядоченных на поверхности $Si(001)$

1028

Колодезный Е.С., Курочкин А.С., Рочас С.С., Бабичев А.В., Новиков И.И., Гладышев А.Г., Карачинский Л.Я., Савельев А.В., Егоров А.Ю., Денисов Д.В.

Влияние легирования барьерных слоев на эффективность фотолюминесценции напряженных гетероструктур $InGaAlAs/InGaAs/InP$

1034

Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Кастро Р.А., Грабко Г.И., Кононов А.А.

Низкочастотная диэлектрическая релаксация в стеклообразной системе $Ge_{28.5}Pb_{15}S_{56.5}$ с примесью железа

1038

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Середин П.В., Леньшин А.С., Федюкин А.В., Голощаров Д.Л., Лукин А.Н., Арсентьев И.Н., Жаботинский А.В.

Влияние режимов электрохимического травления на морфологию, структурные и оптические свойства пористого арсенида галлия

1041

Орлецкий И.Г., Илащук М.И., Солован М.Н., Марьянчук П.Д., Парфенюк О.А., Майструк Э.В., Ничий С.В.

Электрические свойства и энергетические параметры гетеропереходов $n-FeS_2/p-Cd_{1-x}Zn_xTe$

1049

Володин В.А., Rui Zhang, Кривякин Г.К., Антоненко А.Х., Stoffel M., Rinnert H., Vergnat M. Формирование светоизлучающих в ИК-диапазоне нанокристаллов германия в пленках Ge:SiO₂	1056
Саидов А.С., Лейдерман А.Ю., Усмонов Ш.Н., Амонов К.А. Эффект инжекционного обеднения в p-Si-n-(Si₂)_{1-x}(ZnSe)_x (0 ≤ x ≤ 0.01) гетероструктуре	1066
Тепляков М.П., Кен О.С., Горячев Д.Н., Сресели О.М. Транспорт и фоточувствительность в структурах: композитный слой из наночастиц кремния и золота на p-Si	1071
Углеродные системы	
Рутьков Е.В., Галль Н.Р. Интеркалирование молекул фуллерена C₆₀ под однослойный графен на карбиде молибдена	1076
Физика полупроводниковых приборов	
Клочко Н.П., Копач В.Р., Хрипунов Г.С., Корсун В.Е., Любов В.Н., Жадан Д.О., Отченашко А.Н., Кириченко М.В., Хрипунов М.Г. Гетероструктура для обращенного диода на основе электроосажденного в импульсном режиме наномассива оксида цинка и изготовленной методом SILAR пленки иодида меди	1081
Куницына Е.В., Андреев И.А., Коновалов Г.Г., Иванов Э.В., Пивоварова А.А., Ильинская Н.Д., Яковлев Ю.П. Фотодиоды для ближней инфракрасной области спектра на основе GaSb/GaAlAsSb-гетероструктур	1094
Дубинов А.А., Алешкин В.Я., Морозов С.В. Снижение порога генерации с помощью легирования в лазерах среднего инфракрасного диапазона на основе HgCdTe с квантовыми ямами HgTe	1100
Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур	
Анисимов А.Н., Вольфсон А.А., Мохов Е.Н. Спектры рамановского рассеяния толстых эпитаксиальных слоев GaN на SiC, полученных сублимационным сандвич-методом	1104